

УДК 539.143.43

© 1990

## ПРОТОННАЯ СПИН-РЕШЕТОЧНАЯ РЕЛАКСАЦИЯ В КРИСТАЛЛАХ $\text{NH}_4\text{IO}_3 \cdot 2\text{HIO}_3$ И $\text{KIO}_3 \cdot 2\text{HIO}_3$

Д. Ф. Байса, Е. Д. Чесноков, А. И. Шанчук

В интервале температур 285—77 К исследована температурная зависимость времени  $T_1$  протонной спин-решеточной релаксации (ПСРР) кристаллов  $\text{NH}_4\text{IO}_3 \cdot 2\text{HIO}_3$  (АИН) и  $\text{KIO}_3 \cdot 2\text{HIO}_3$  (КИН). Показано, что ПСРР в кристалле АИН контролируется реориентационным движением тетраэдров  $\text{NH}_4$ , что обеспечивает в исследованной области температур изменение  $T_1$  от 6.7 мс до 1.9 с. ПСРР в КИН интерпретируется как результат движения протонов в двухъярусном потенциале водородных контактов:  $\text{O} \cdots \text{H} \cdots \text{O}$  выше температуры  $T_c = 214$  К структурного фазового перехода,  $\text{O} \cdots \text{H} \cdots \text{O}$  при  $T < T_c$ . Этот механизм релаксации менее эффективен по сравнению с действующим в кристалле АИН:  $T_1$  варьирует в интервале значений 2.5—55 с. При  $T < 100$  К следует учитывать туннельное движение протонов. Определены величины термоактивационных барьеров и температурные зависимости времени корреляции процессов, обусловливающих ПСРР в кристаллах АИН и КИН.

Изоструктурные кристаллы  $\text{NH}_4\text{IO}_3 \cdot 2\text{HIO}_3$  и  $\text{KIO}_3 \cdot 2\text{HIO}_3$ , согласно рентгене<sup>[1, 2]</sup>- и нейтронографическим<sup>[3]</sup> данным, характеризуются при 300 К триклинической симметрией: пр. гр.  $P\bar{1}$ ,  $z=2$ . В обоих кристаллах при  $T_c = 213$  К<sup>[2]</sup> наблюдается структурный фазовый переход (ФП) второго рода. Величины электропроводности и диэлектрической проницаемости незначительно изменяются при замещении группы  $\text{NH}_4$  на атом калия.

Нейтронографический анализ структуры АИН (300 К) обнаруживает три неэквивалентные группы  $\text{IO}_3$ <sup>[3]</sup>. Тетраэдры  $\text{I}(2)\text{O}_3$  и  $\text{I}(3)\text{O}_3$  связываются в цепочки с помощью водородных контактов, как стабильных  $\text{O} \cdots \text{H} \cdots \text{O}$ , так и бифуркированных  $\text{O} \cdots \text{H} \cdots \text{O}$ . Группы  $\text{NH}_4$  в кристалле АИН образуют водородные контакты с  $\text{I}(1)\text{O}_3$  и цепочками из иодатных групп. Цепочечная структура из тетраэдров  $\text{I}(2)\text{O}_3$  и  $\text{I}(3)\text{O}_3$  характерна и для кристалла КИН<sup>[1]</sup>.

Спектр ЯКР  $^{127}\text{I}$  в кристаллах АИН и КИН выше  $T_c$  не наблюдается. При 77 К число линий в спектре ЯКР равно шести<sup>[4]</sup> (шесть неэквивалентных групп  $\text{IO}_3$ ).

Модель ФП в АИН и КИН предполагает, что при  $T < T_c$  происходит упорядочение в несимметричном двухъярусном потенциале протонов, образующих при температурах выше ФП контакты  $\text{O} \cdots \text{H} \cdots \text{O}$  и локализованных вблизи центров симметрии структуры кристалла. ФП, по-видимому, сопровождается удвоением объема исходной элементарной ячейки симметрии  $C_i$ <sup>[4]</sup>. При этом центр симметрии структуры сохраняется<sup>[5]</sup>.

В кристаллах АИН и КИН при  $T > T_c$  обнаружена высокая ионная проводимость ( $\sim 10^{-6}$  Ом $^{-1}$ ·см $^{-1}$  при 300 К<sup>[2]</sup>), обусловленная тем, что число протонов меньше, чем число возможных мест их локализации в структуре. Вероятно, в проводимости участвуют ионы водорода, образующие контакты  $\text{O} \cdots \text{H} \cdots \text{O}$ <sup>[3]</sup>.

В<sup>[2]</sup> представлены результаты исследования протонного магнитного резонанса (ПМР) в кристаллах АИН и КИН. В интервале температур 160—320 К в АИН наблюдаются две линии спектра — широкая и узкая, в КИН — одна узкая линия. Широкая компонента спектра в АИН отнесена к группам  $\text{NH}_4$ . При понижении температуры от 240 до 190 К происходит уширение узких линий.

В настоящей работе проведено исследование температурной зависимости времени СРР протонов в поликристаллических образцах АИН и КИН. Измерения выполнены с помощью когерентного импульсного спектрометра ИСП-1 на частоте  $\omega_0/2\pi = 19.2$  МГц. Для возбуждения спиновой системы и регистрации временного изменения намагниченности использовалась последовательность импульсов  $90^\circ - \tau - 90^\circ - \tau - \dots$  («прогрессивное насыщение»). Накопление сигналов ЯМР позволило увеличить отношение сигнал/шум. Временной спад сигнала свободной индукции после  $90^\circ$ -импульса характеризуется в случае АИН и КИН одним временем релаксации. Погрешность определения  $T_1$  не превышает  $\pm 5\%$ .

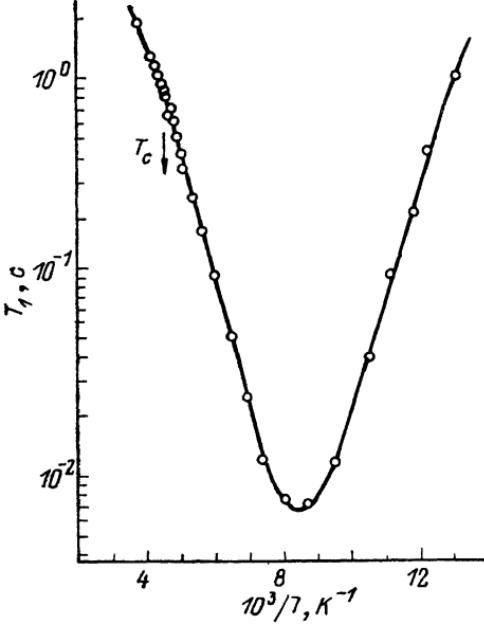


Рис. 1. Температурная зависимость времени спин-решеточной релаксации протонов в кристалле  $\text{NH}_4\text{IO}_3 \cdot 2\text{HIO}_3$ .  $T_c = 214$  К.

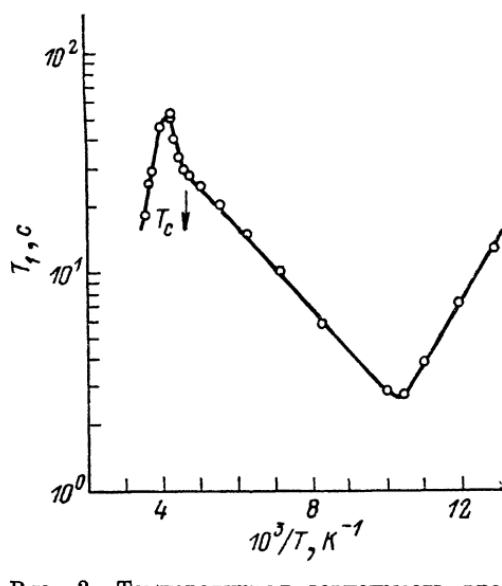


Рис. 2. Температурная зависимость времени спин-решеточной релаксации протонов в кристалле  $\text{KIO}_3 \cdot 2\text{HIO}_3$ .  $T_c = 214$  К.

Измерения  $T_1$  проводились в интервале температур 77—285 К с помощью азотного криостата. Погрешность стабилизации температуры не превышала  $\pm 0.1$  К. Температура контролировалась платиновым термометром сопротивления.

На рис. 1, 2 представлены температурные зависимости времени  $T_1$  СРР протонов для кристаллов АИН и КИН соответственно. При  $T = 214 \pm 1$  К заметно изменение наклона линейного участка зависимости  $\ln T_1 (T^{-1})$ , что, по-видимому, связано с ФП. Минимум  $T_1$  наблюдается при температуре  $T_{\min} = 119.4$  К в кристалле АИН и при 96.9 К в КИН. В исследованной области температур время СРР изменяется от 2.5 до 55 с для КИН и от 6.7 мс до 1.9 с для АИН.

При  $T \approx 241$  К в  $\text{KIO}_3 \cdot 2\text{HIO}_3$  обнаруживается максимум  $T_1$ , а в кристалле  $\text{NH}_4\text{IO}_3 \cdot 2\text{HIO}_3$  выше  $T_c$  температурная зависимость имеет моноитонный характер.

Наблюданное различие (примерно на три порядка) времен протонной СРР в исследованных кристаллах с учетом их изоструктурности, очевидно, связано с замещением группы  $\text{NH}_4$  на атом калия. Причина существенного увеличения времени релаксации при переходе от АИН к КИН — в изменении механизма протонной СРР. При нейтронографическом исследовании кристалла  $\text{NH}_4\text{IO}_3 \cdot 2\text{HIO}_3$  установлена высокая подвижность протонов из  $\text{NH}_4$ -групп, обусловленная большой амплитудой крутильных тепловых колебаний тетраэдра [3]. По-видимому, реориентационное вращение группы  $\text{NH}_4$  обеспечивает эффективный канал СРР как выше ФП,

так и ниже  $T_c$ . В предположении термоактивированного процесса реориентации группы  $\text{NH}_4$  по экспериментальным данным (рис. 1) можно определить барьер активации  $E_a$  и температурную зависимость времени корреляции  $\tau_c = \tau_0 \exp(E_a/RT)$ , где  $\tau_c$  — среднее время жизни молекулы в данном состоянии,  $R = 1.986 \cdot 10^{-3}$  ккал/моль·град. Время  $T_1$  CPP, обусловленной диполь-дипольным взаимодействием спинов протонов группы  $\text{NH}_4$ , определяется известным соотношением

$$T_1^{-1} = \frac{3}{10} \gamma^4 \hbar^2 r^{-6} \left( \frac{\tau_c}{1 + \omega_0^2 \tau_c^2} + \frac{4\tau_c}{1 + 4\omega_0^2 \tau_c^2} \right), \quad (1)$$

где  $r$  — среднее расстояние между атомами водорода группы  $\text{NH}_4$ . Учитывая, что в минимуме  $T_1$  при температуре 119.4 К  $\omega_0 \tau_c = 0.616$ , легко оценить постоянную времени корреляции  $\tau_0 = 1.07 \cdot 10^{-14}$  с. Выражение  $\tau_c = 1.07 \cdot 10^{-14} \exp(3.1/RT)$  определяет температурную зависимость времени корреляции реориентаций группы  $\text{NH}_4$  в области температур  $T < T_c$ , где  $\omega_0 \tau_c \ll 1$ . Так, вблизи ФП при  $T = 210$  К  $\tau_c$  составляет  $\approx 1.9 \cdot 10^{-11}$  с. Уменьшение  $E_a$  при  $T < T_{\min}$ , возможно, связанное с наличием нескольких мод колебаний группы  $\text{NH}_4$ , приводит к зависимости  $\tau_c = 1.07 \cdot 10^{-14} \exp(2.6/RT)$ . При 77 К  $\tau_c = 2.7 \cdot 10^{-7}$  с. Для сравнения приведем величины энергии активации  $E_a$  (ккал/моль) и постоянной времени корреляции  $\tau_0$  (с) реориентации группы  $\text{NH}_4$  в кристаллах  $\alpha\text{-NH}_4\text{HgCl}_3$  и  $\text{NH}_4\text{ReO}_4$  соответственно: 2.25,  $1.3 \cdot 10^{-14}$  [5, 6] и 2.0,  $3.6 \cdot 10^{-14}$  [7]. Совпадение по порядку величины значений  $E_a$  и  $\tau_0$  с экспериментальными данными для  $\text{NH}_4\text{IO}_3 \cdot 2\text{HIO}_3$  подтверждает правильность выбранной модели CPP протонов в этом кристалле.

Используя структурные данные для АИН, можно оценить время  $T_1$  в минимуме температурной зависимости. С учетом  $\omega_0 \tau_c = 0.616$  и  $r \approx 1.64$  Å [3] из (1) получено значение  $T_1 \approx 9.8$  мс, близкое к экспериментальной величине 6.7 мс.

В результате перестройки структуры кристалла АИН при ФП происходит изменение барьера активации реориентационных движений группы  $\text{NH}_4$  — в высокотемпературной фазе  $E_a$  становится меньше и составляет 2.1 ккал/моль.

Сравним полученные из температурной зависимости  $T_1$  CPP величины энергии активации (ккал/моль) (2.1 для  $T > T_c$ , 3.1 для  $T_c > T > T_{\min}$ , 2.6 для  $T < T_{\min}$ ) с данными, полученными из измерений электропроводности и динамического сужения линий спектра ЯМР в кристалле АИН. Для термоактивации электропроводности в АИН, обусловленной, по-видимому, прыжками протонов бифурцированных водородных контактов  $\text{O} \cdots \text{H} \cdots \text{O}$  между возможными местами их локализации, необходимо затратить энергию  $E_a = 11$  ккал/моль [2]. Оценка активационного барьера для подвижности протонов, выполненная по данным ЯМР с помощью соотношения Юо—Федина [8]  $E_a \approx 37 T_n$  ккал/моль, где  $T_n$  соответствует середине температурной области динамического сужения линии ПМР (190–240 К), дает величину 7.9 ккал/моль [2]. Мы полагаем, что эта оценка некорректна, поскольку при  $T = 214$  К происходит ФП. Соотношение Юо—Федина не учитывает возможности изменения в области сужения линии спектра ЯМР энергии активации  $E_a$  реориентационных движений, например, в результате структурного ФП.

Очевидно, что в кристалле  $\text{KIO}_3 \cdot 2\text{HIO}_3$  в отличие от  $\text{NH}_4\text{IO}_3 \cdot 2\text{HIO}_3$  экспериментально наблюдается релаксация протонов, связывающих группы  $\text{IO}_3$ . В случае АИН релаксация спинового возбуждения этой подсистемы протонов осуществляется, по-видимому, через канал CPP, образуемый реориентационным движением групп  $\text{NH}_4$ .

Температурная зависимость  $T_1$  в кристалле КИН характеризуется рядом особенностей. В области температур  $T < T_c$  наблюдается асимметричный минимум  $T_1$  (рис. 2) в отличие от предсказываемого теорией CPP Бломбергена—Парсельла—Паунда симметричного минимума. Обращают на себя внимание также относительно малые абсолютные значения

активационных барьеров, определенные из наклонов графика  $\ln T_1 (T^{-1})$ : 0.86 и 1.24 ккал/моль для  $\omega_0 \tau_c \ll 1$  и  $\omega_0 \tau_c \gg 1$  соответственно. Известно [9], что асимметричный минимум  $T_1$  должен наблюдаться в случае CPP, обусловленной движением спина между двумя неэквивалентными положениями с разностью энергий  $\Delta E$ .

Исходя из структуры кристалла КИИ и модели ФП, можно предположить, что CPP  $^1\text{H}$  при  $T < T_c$  происходит в результате движения упорядочивающихся при ФП протонов в асимметричном ( $\Delta E$ ) двухъяйном потенциале водородных контактов O—H...O. Для времени корреляции  $\tau_c$  можно записать в этом случае

$$\tau_c^{-1} = v_{1-2} + v_{2-1}, \quad (2)$$

где частоты  $v_{1-2}$ ,  $v_{2-1}$  прыжков протона из ямы 1 в яму 2 и обратно определяются соотношениями

$$v_{1-2} = v_0 \exp [-(H + \Delta E)/RT], \quad v_{2-1} = v_0 \exp (-H/RT), \quad (3)$$

$H$  — энергетический барьер для прыжков протона из мелкой ямы 2 в глубокую 1. Как следует из (2), (3), при условии  $\Delta E \gg RT$  время корреляции  $\tau_c$  определяется прыжками протона из мелкой ямы в глубокую

$$\tau_c = \tau_0 \exp (H/RT). \quad (4)$$

Выражение для скорости CPP, обусловленной движением спина в асимметричном двухъяйном потенциале, имеет вид [9]

$$T_1^{-1} \sim \frac{a}{(a+1)^2} \left( \frac{\tau_c}{1 + \omega_0^2 \tau_c^2} + \frac{4\tau_c}{1 + 4\omega_0^2 \tau_c^2} \right),$$

где  $a = v_{2-1}/v_{1-2} = \exp (\Delta E/RT)$ . Если выполняется условие  $\Delta E \gg RT$ , выражение для  $T_1$  упрощается

$$T_1 \sim a\tau_c^{-1} \sim \exp [-(H - \Delta E)/RT], \quad \omega_0 \tau_c \ll 1; \quad T_1 \sim a\tau_c \sim \exp [(H + \Delta E)/RT], \quad \omega_0 \tau_c \gg 1.$$

Таким образом, наклон графика зависимости  $T_1 (T^{-1})$  будет разным выше и ниже температуры минимума  $T_1$ :  $H - \Delta E = 0.86$ ,  $H + \Delta E = 1.24$  ккал/моль. Отсюда следует, что  $H = 1.05$  ккал/моль,  $\Delta E = 0.19$  ккал/моль. Очевидно, условие  $\Delta E \gg RT$  не выполняется в исследованной области температур, что противоречит модели ФП.

Другое противоречие возникает при использовании величины  $H$  для расчета  $\tau_0$  с помощью (4). Действительно, соотношение  $\omega_0 \tau_c = 0.616$ , которое выполняется при  $T_{\min} = 96.9$  К, определяет величину  $\tau_c = 5.1 \cdot 10^{-9}$  с. Следовательно,  $\tau_0$  будет равно  $2.2 \cdot 10^{-11}$  с. С другой стороны, постоянную времени корреляции  $\tau_0$  можно оценить как обратную частоту продольного колебания протона на ковалентной связи O—H. Длина водородного контакта  $R$  (O...O)  $\approx 2.55$  Å [1] в кристалле КИИ, согласно корреляционной зависимости  $v_{0-H}(R)$  (O...O) [16], соответствует частота  $v_{0-H} \approx 2300$  см<sup>-1</sup>, т. е.  $\tau_0 = 1.4 \cdot 10^{-14}$  с.

Объяснить различие на три порядка полученных оценок  $\tau_0$  можно, если предположить, что рост эффективности протонного туннелирования при температурах ниже 100 К приводит к ослаблению температурной зависимости времени  $T_1$ , т. е. к понижению наклона графика  $\ln T_1 (T^{-1})$ . В этом случае заниженными оказываются величина  $H + \Delta E = 1.24$  ккал/моль, а также параметры двухъяйного потенциала и частота O—H колебаний.

Исходя из этого предположения, определим истинные параметры  $H$  и  $\Delta E$ . Для этого используем соотношение (4) и значения  $\tau_0 = 1.4 \cdot 10^{-14}$ ,  $\tau_c = 5.1 \cdot 10^{-9}$  с при  $T_{\min} = 96.9$  К. Полученная величина барьера  $H = -2.46$  ккал/моль позволяет найти  $\Delta E$  с учетом равенства  $H - \Delta E = -0.86$  ккал/моль. Таким образом, в области температур  $T < T_c$  асимметричный двухъяйный потенциал водородного контакта O...H—O характеризуется параметрами:  $H = 2.46$  ккал/моль,  $\Delta E = 1.6$  ккал/моль, а тем-

пературная зависимость времени корреляции имеет вид  $\tau_c = 1.4 \times 10^{-14} \exp(2.46/RT)$ . Важно отметить, что  $\Delta E \gg RT$  во всей области температур ниже  $T_c$ , что согласуется с моделью упорядочения протонов при ФП. Параметр асимметрии  $a$  двухъя姆ного потенциала при  $T=210$  К равен 47.5, а при  $T=77$  К  $a=3.7 \cdot 10^4$ . Легко оценить также величину барьера  $U$ , разделяющего ямы в неупорядоченной фазе кристалла ( $T > T_c$ ):  $U=H+\Delta E/2=3.28$  ккал/моль.

ФП в кристалле  $\text{KIO}_3 \cdot 2\text{HIO}_3$  проявляется на температурной зависимости  $T_1$  изменением наклона графика  $\ln T_1 (T^{-1})$  при  $T_c=214$  К. Барьер активации CPP в интервале температур 214—241 К  $E_a=3.46$  ккал/моль. Эта величина близка к оценке, полученной выше для барьера  $U$  симметричного двухъя姆ного потенциала. Таким образом, CPP протонов в указанном интервале температур может быть обусловлена термоактивированным движением протонов в симметричном двухъямном потенциале бифурцированных водородных контактов  $\text{O}\cdots\text{H}\cdots\text{O}$ . При  $T=220$  К частота прыжков протонов составляет  $v \approx 6.9 \cdot 10^{13} \exp(-3.46/RT) = 2.5 \cdot 10^{10}$  Гц. Изменение  $E_a$  при ФП, очевидно, связано с перестройкой структуры кристалла.

Величина  $T_1$  достигает максимальной величины 55 с при 241 К, затем время CPP уменьшается и температуре  $T=283$  К соответствует значение  $T_1=18$  с. В исследованной области температур выше 241 К энергия активации  $E_a=3.83$  ккал/моль. Очевидно, что спад  $T_1$  обусловлен «включением» нового механизма релаксации протонов, а наклон графика температурной зависимости  $T_1$  отвечает условию  $\omega_0 \tau_c \gg 1$ , т. е. движение спинов протонов происходит с частотой корреляции, значительно меньшей 19.2 МГц. Можно предположить, что это низкочастотные макроскопические движения групп атомов, дающие также вклад в диэлектрическую проницаемость, например, в направлении [100] при температурах выше 240 К [5].

Таким образом, перестройка структуры при фазовом переходе в обоих кристаллах проявляется в изменении наклона температурной зависимости  $T_1$  при  $T_c$ . В кристалле  $\text{NH}_4\text{IO}_3 \cdot 2\text{HIO}_3$  протонная CPP обусловлена реориентационным движением группы  $\text{NH}_4$  в интервале температур 260—77 К. Этот же механизм, по-видимому, обеспечивает и релаксацию протонов, связывающих в структуре кристалла группы  $\text{IO}_3$ , через их спин-спиновое взаимодействие с протонами  $\text{NH}_4$ -групп. При температуре фазового перехода происходит изменение барьера термоактивации реориентационного движения  $\text{NH}_4$ -групп.

В кристалле  $\text{KIO}_3 \cdot 2\text{HIO}_3$  действует менее эффективный механизм протонной CPP, связанный с движением протона в двухъямном потенциале водородного контакта  $\text{O}\cdots\text{H}\cdots\text{O}$  и  $\text{O}-\text{H}\cdots\text{O}$ . При температурах  $T < 100$  К становится заметным и вклад в CPP протонного туннелирования. Изменение барьера активации релаксации при  $T_c$  соответствует переходу от симметричного двухъямного потенциала с  $E_a=3.46$  ккал/моль к асимметричному с  $H=2.46$  ккал/моль и  $\Delta E=1.6$  ккал/моль, что является подтверждением модели фазового перехода типа «порядок—беспорядок» в кристалле  $\text{KIO}_3 \cdot 2\text{HIO}_3$ .

## Список литературы

- [1] Вавилин В. И., Илюхин В. В., Белов Н. В. // ДАН СССР. 1976. Т. 226. № 6. С. 1319—1321.
- [2] Барапов А. И., Добржанский Г. Ф., Илюхин В. В., Рябкин В. С., Соколов Ю. И., Сорокина Н. И., Шувалов Л. А. // Кристаллография. 1981. Т. 26. № 6. С. 1259—1268.
- [3] Сорокина Н. И., Мурадян Л. А., Лошманов А. А., Фыкин Л. Е., Ридер Е. Э., Добржанский Г. Ф., Симонов В. И. // Кристаллография. 1984. Т. 29. № 2. С. 220—227.
- [4] Байса Д. Ф., Барабаш А. И., Шадчин Е. А., Шанчук А. И., Шишгин В. А. // Кристаллография. 1989. Т. 34. № 4. С. 1025—1027.
- [5] Барапов А. И., Добржанский Г. Ф., Илюхин В. В., Калинин В. Р., Рябкин В. С., Шувалов Л. А. // Кристаллография. 1979. Т. 24. № 2. С. 280—283.
- [6] Sagisawa K., Kiriyama H., Kiriyama R. // Chem. Lett. 1975. N 12. P. 1285—1288.

- [7] Petch H. E., Reynhardt E. C., Watton A. // J. Magn. Res. 1978. V. 29. P. 1—6.  
[8] Уо Дж. С., Федин Э. И. // ФТТ. 1962. Т. 4. № 8. С. 2233—2237.  
[9] Look D. C., Lowe I. J. // J. Chem. Phys. 1966. V. 44. N 9. P. 3437—3441.  
[10] Matsushita E., Matsubara T. // Progr. Theor. Phys. 1982. V. 67. N 1. P. 1—19.

Институт физики АН УССР  
Киев

Поступило в Редакцию  
3 мая 1990 г.